

2SC5384

高周波増幅、中間周波増幅用
シリコン NPN エピタキシャル形(ウルトラスーパーミニタイプ)

概要

2SC5384は、超小形外形樹脂封止形シリコンNPNエピタキシャル形トランジスタで、FM・AMラジオの高周波増幅、発振、周波数交換、中間周波増幅用に設計、製造されております。
セットの小形化、高密度実装用として幅広くご使用いただけます。
SC-59外装のトランジスタ2SC3053相当の特性を有しています。

特長

- 超小形外形のため、セットの小型化、高密度実装が可能です。
- 高利得 10.7MHz、MAG=45dB標準
- 低雑音 10.7MHz、NF=3.0dB標準
- y_{re} が小さい10.7MHz、 $y_{re} = -j0.11\text{ms}$ 標準

用途

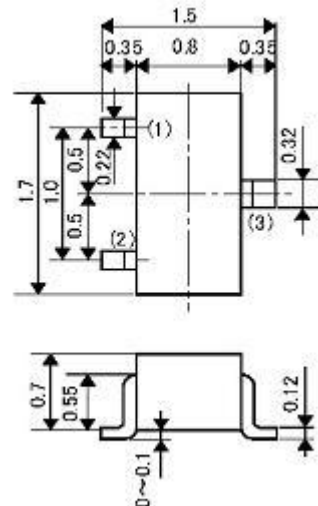
小形通信機、FM/AM ラジオ等の高周波増幅、発振、混合、周波数交換及び中間周波増幅器

最大定格 (Ta=25°C)

記号	項目	定格値	単位
V _{CB0}	コレクタ・ベース間電圧	30	V
V _{EB0}	エミッタ・ベース間電圧	4	V
V _{CE0}	コレクタ・エミッタ間電圧	25	V
I _C	コレクタ電流	30	mA
P _C	コレクタ損失	125	mW
T _J	接合部温度	+150	°C
T _{stg}	保存温度	-55~ +150	°C

外形図

単位:mm



JEITA: -

JEDEC: -

電極接続

①: ベース

②: エミッタ

③: コレクタ

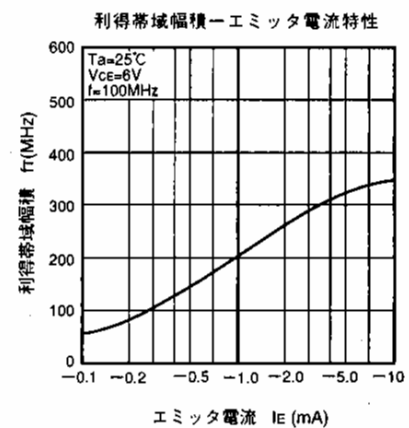
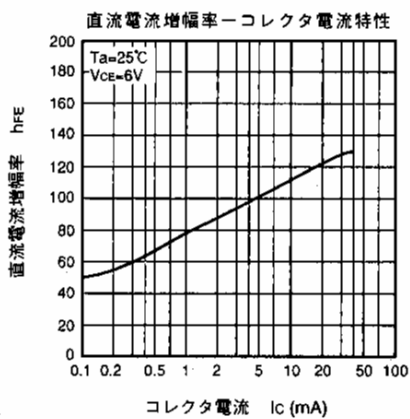
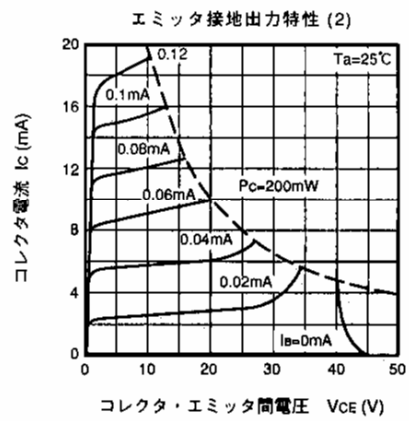
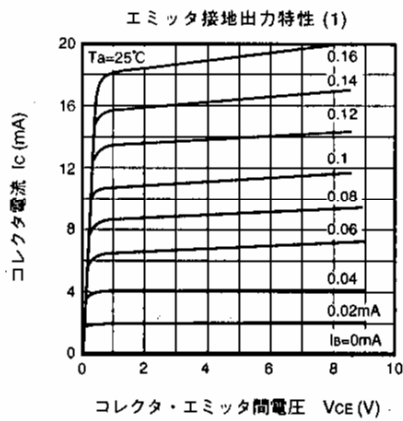
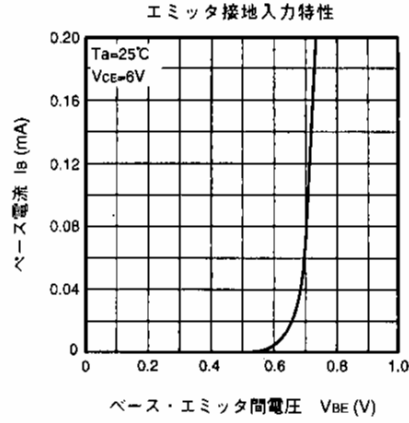
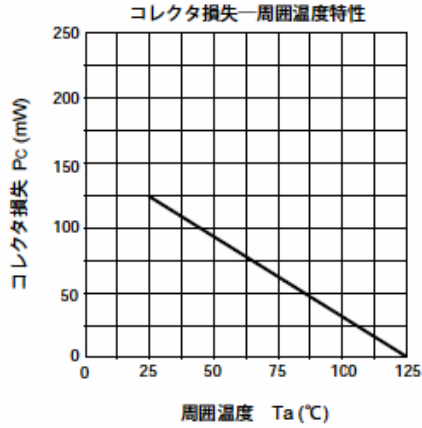
電気的特性 (Ta=25°C)

項目	記号	試験条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
コレクタ遮断電流	I _{CB0}	V _{CB} =25V, I _E =0mA	-	-	1	μA
エミッタ遮断電流	I _{EB0}	V _{EB} =4V, I _C =0mA	-	-	1	μA
直流電流増幅率	hFE	V _{CE} =6V, I _C =1mA	35	-	180	-
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =10mA, I _B =1mA	-	0.1	0.3	V
利得帯域幅積	fT	V _{CE} =6V, I _E =-1mA	150	200	-	MHz
コレクタ出力容量	C _{ob}	V _{CB} =6V, I _E =0mA, f=1MHz	-	2.0	2.7	pF
ベース時定数	C _{crb'b}	V _{CB} =6V, I _E =-1mA, f=31.8MHz	-	20	60	pS
雑音指数	NF	V _{CB} =6V, I _E =-1mA, f=10.7MHz, R _G =500Ω	-	3.0	-	dB

※hFE の値により、右表のようにアイテム分類を行っております

アイテム	B	C	D
hFE	35~70	55~110	90~180
マーク	FB	FC	FD

標準特性



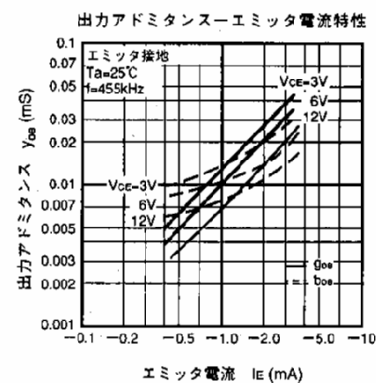
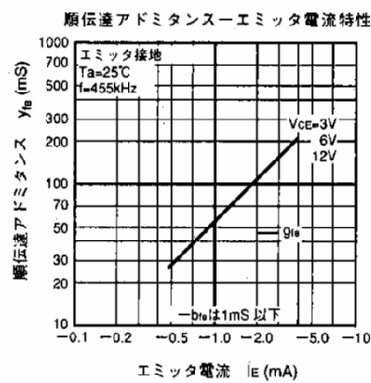
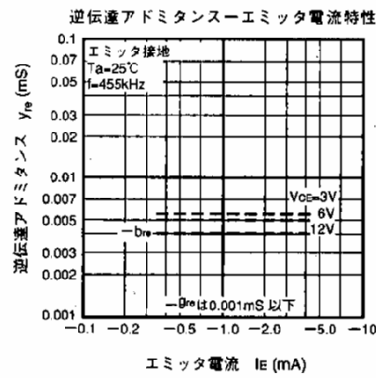
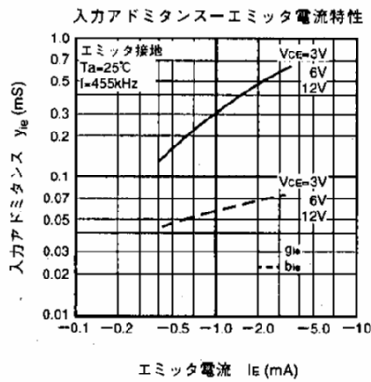
2SC5384

高周波増幅、中間周波増幅用
シリコン NPN エピタキシャル形(ウルトラスーパーミニタイプ)

エミッタ接地, yパラメータ (標準値) (Ta=25°C)

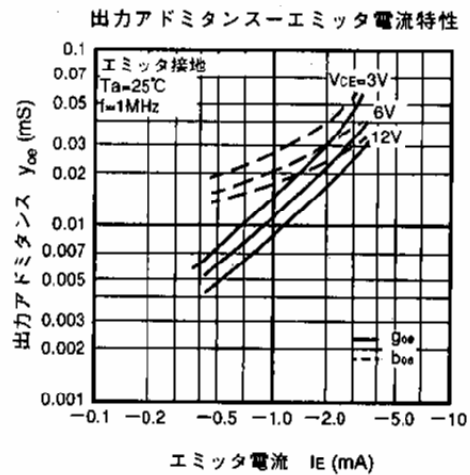
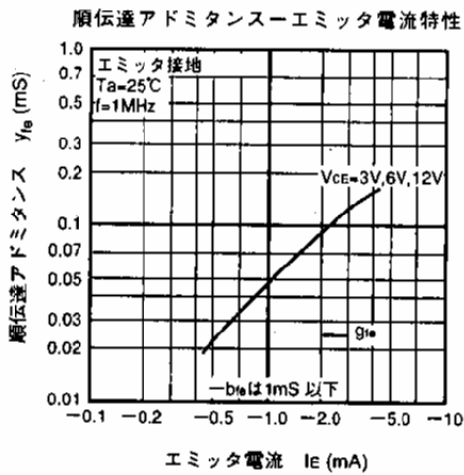
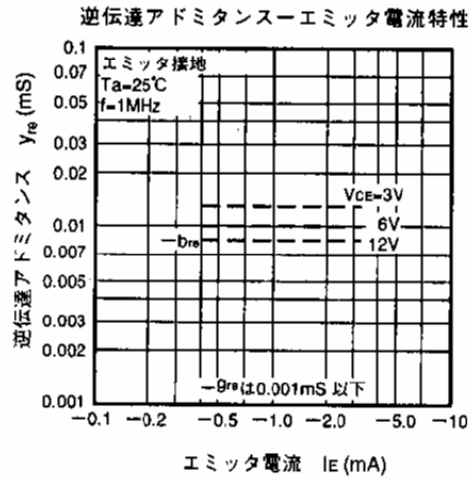
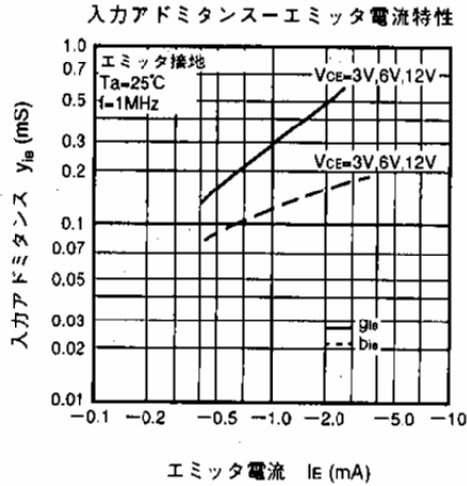
測定条件		f=455kHz Vce=6V Ie=-1mA	f=1MHz Vce=6V Ie=-1mA	f=10.7MHz Vce=6V Ie=-1mA	f=100MHz Vce=6V Ie=-1mA
y _{ie} (mS)	g _{ie}	0.30	0.30	0.38	4.4
	b _{ie}	0.06	0.12	1.40	11.0
y _{re} (mS)	-g _{re}	0.001以下	0.001以下	0.005以下	0.05以下
	-b _{re}	0.005	0.010	0.11	1.0
y _{fe} (mS)	g _{fe}	50	46	37	25
	-b _{fe}	1.0以下	1.0以下	2.8	16
y _{oe} (mS)	g _{oe}	0.010	0.012	0.03	0.32
	b _{oe}	0.011	0.022	0.18	1.3

エミッタ接地, 455kHz yパラメータ

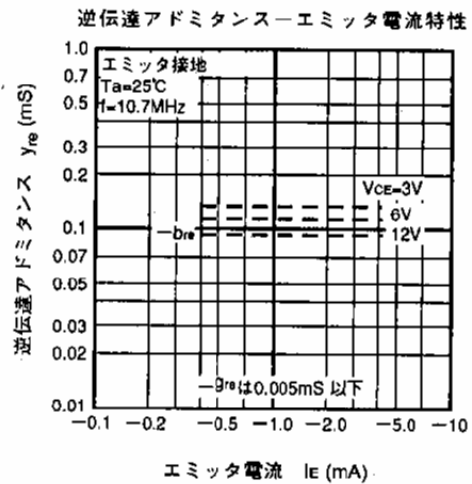
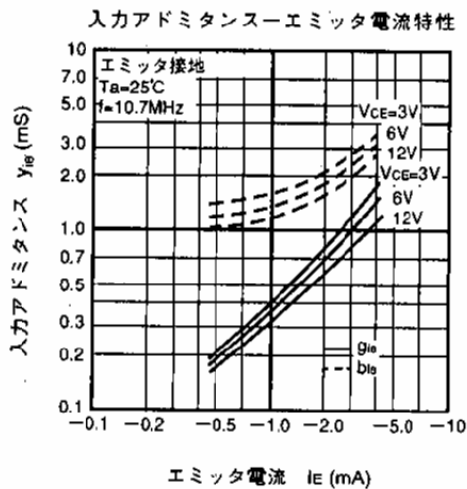


高周波増幅、中間周波増幅用
シリコン NPN エピタキシャル形(ウルトラスーパーミニタイプ)

エミッタ接地, 1MHz yパラメータ

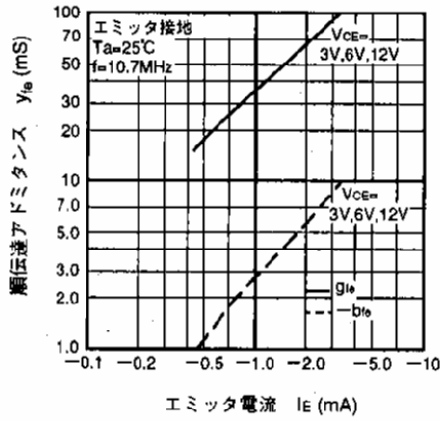


エミッタ接地, 10.7MHz yパラメータ

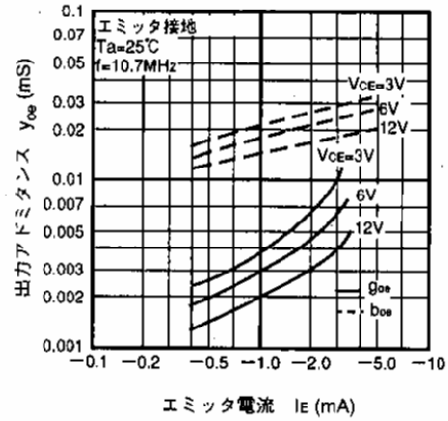


高周波増幅、中間周波増幅用
シリコン NPN エピタキシャル形(ウルトラスーパーミニタイプ)

順伝達アドミタンス-エミッタ電流特性

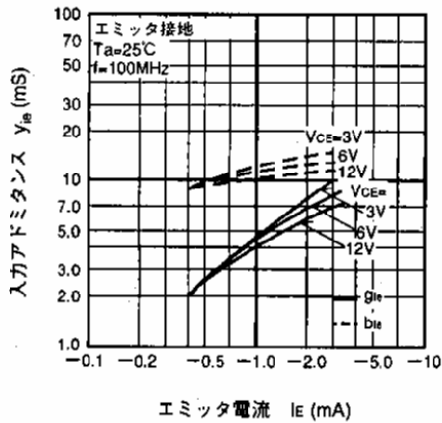


出力アドミタンス-エミッタ電流特性

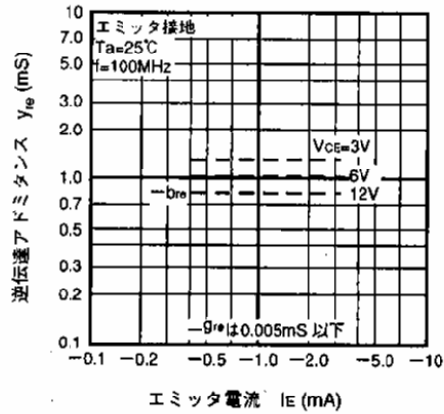


エミッタ接地、100MHz yパラメータ

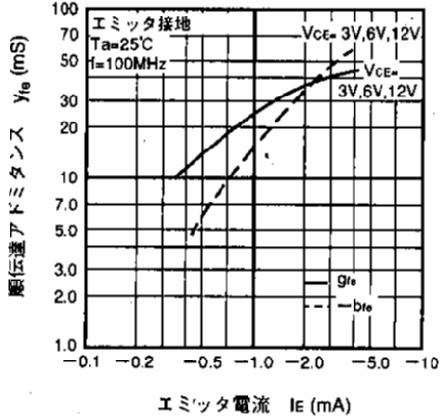
入力アドミタンス-エミッタ電流特性



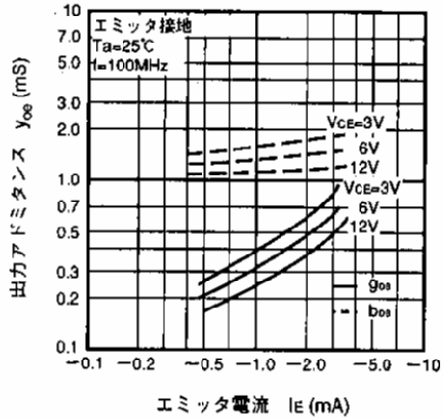
逆伝達アドミタンス-エミッタ電流特性



順伝達アドミタンス-エミッタ電流特性



出力アドミタンス-エミッタ電流特性



安全設計に関するお願い

- ・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社製品の故障または誤動作によって、結果として人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご注意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切なイサハヤ電子製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてイサハヤ電子が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、イサハヤ電子は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他全ての情報は、本資料発行時点のものであり、特性改良などにより予告なしに変更することがあります。製品の購入に当たっては、事前にイサハヤ電子へ最新の情報をご確認ください。
- ・本資料に記載された製品は、人命に関わるような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海中継機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、イサハヤ電子へ御照会ください。
- ・本資料の転載、複製については、文書によるイサハヤ電子の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点がございましたら、イサハヤ電子まで御照会ください。